多晶硅如何磨细,多晶硅棒热破碎装置

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

多晶硅如何磨细,多晶硅棒热破碎装置

本发明多晶硅如何磨细,多晶硅棒热破碎装置还提供了一种制造本发明的P型区－本征区－N型区二极管的方法，该方法与诸如硅锗BiCMOS工艺的现代RF技术兼容。CN纳米多晶硅栅刻蚀－氟化+反应离子刻蚀方法一种纳米多晶硅栅刻蚀－氟化+反应离子刻蚀方法，本方法包括：步骤一：采用为氟化处理技术；步骤二：采用为纳米电子束胶图形的转移技术；其在现有设备的基础上实现超微细加工，同时具有成本低和工艺简单的优点，实现了高保真度的图形转移，并具有较强的抗腐蚀能力。CN制备多晶硅颗粒的方法和装置本发明涉及制备多晶硅的方法和装置，更具体地说，为了更有效地防止硅沉积在反应气供给装置的出口表面上以及能连续地运转反应器以批量生产多晶硅颗粒，本发明涉及的是通过装备有可提供含有氯化氢蚀刻气体的喷嘴的流化床反应器制备粒状多晶硅的方法和装置。CN多晶硅化学气相沉积方法和装置由化学气相沉积(CVD)工艺在管件上产生大块多晶硅。石英外壳和底板形成CVD反应器空间，由外辐射加热器穿过反应器壁提供热量，气体进口和出口位于底板上。

在双管反应器中，直立中间管被支撑于室管内使工艺气体越过中间管上方及下方完全流通，从而使沉积得以发生在三个暴露的管表面上。CN评定多晶硅的方法和系统及制造薄膜晶体管的方法和系统提供一种客观地准确地自动地以非接触方式评定多晶硅膜的状态的方法。

该方法包括步骤：拾取通过受激准分子激光退火形成的多晶硅膜的表面；将拾取的图象分成每个具有特定的尺寸的网格(mesh)；计算每个网格的对比度；提取拾取的图像中的最高对比度值和最低对比度值，计算二者之间的对比度比率并且在对比度比率的基础上判断多晶硅膜的平均晶粒尺寸。

CN多晶硅其生产方法及生产装置内部具有气泡表观密度为g/cmsup/sup以下的带气泡多晶硅。这样的硅通过在氢的存在下，使含氢熔融的硅的液滴在～秒的时间内自然落下，使之冷却到液滴中封闭有氢气泡的状态而制得。

这样的硅在具有以下结构的装置内制得，在筒状容器中进行硅的析出·熔融氯硅烷类的供给管被插到筒状容器内的硅熔融区，在筒状容器与氯硅烷类的供给管的间隙中供给密封气体。

CN用于评估多晶硅薄膜的装置以不接触方式自动客观地评估多晶硅薄膜状态的多晶硅薄膜评估装置包括可移动的工作台，其上面设置承载多晶硅薄膜的基片；用可见光观察的光学系统，对多晶硅薄膜的表面图像拍照，以实现自动聚焦；用紫外光观察的光学系统，用于获得多晶硅薄膜的表面图像，利用用可见光观察的光学系统进行自动聚焦；以及评估单元，从表面图像评估该多晶硅薄膜表面空间结构的线性和周期性，以根据该线性和周期性的评估结果来评估该多晶硅薄膜的状态。CN基于二氯甲硅烷的化学汽相淀积多晶硅化物膜中异常生长的控制在用于减轻和/或消除基于二氯甲硅烷基的CVD多晶硅硅化物WSisubX/sub膜中底层多晶硅的异常生长的工艺中，第一种技术是在基本上能够避免底层多晶硅结晶的温度进行底层多晶硅层的淀积。

第二种方法是减小甲硅烷SiHsub/sub后冲洗暴露(例如持续时间和/或浓度)，以避免硅侵入到底层多晶硅层，产生异常生长。

CN为快速电可擦除可编程只读存储器单元形成相对于有源区自对准的浮动栅多晶硅层的方法本发明涉及用于在电可编程和可擦除存储器件中隔离有源区的方法和设备。对于每个沟槽，导电材料层的边缘部分以预定的距离△与第一绝缘材料层和可能的绝缘材料块的一部分重叠并在其上延伸。对于每个沟槽，预定的距离△是如此选择的：在对衬底和导电层进行后段处理后，导电材料层的边缘部分对准隔离沟槽的侧壁部分。

CN液晶显示器的多晶硅薄膜晶体管及其制造方法本发明公开了一种用于LCD的多晶硅TFT及其制造方法。TFT包括成型在基板上的有效构图，成型在包括有效构图的基板上的栅绝缘层，成型在栅绝缘层上而横穿该有效构图且包括用于确定第一杂质区第二杂质区和沟道区的栅电极的栅线，成型在包括栅线的栅绝缘层上的绝缘中间层，成型在绝缘中间层上且通过第一接触孔与第二杂质区相连的数据线，以及形成在与数据线相同的绝缘中间层上且通过第二接触孔与第一杂质区相连的象素电极，其中第一接触孔通过栅绝缘层和绝缘中间层成型在第二杂质区上，第二接触孔通过栅绝缘层和绝缘中间层成型在第一杂质区上。CN低温下用顺序横向固化制造单晶或多晶硅薄膜的系统和方法揭示了将非晶硅薄膜样本加工成单晶或多晶硅薄膜的方法和系统。CN用顺序横向固化制

造均匀大晶粒和晶粒边界位置受控的多晶硅薄膜半导体的方法揭示了将非晶硅薄膜样本加工成多晶硅薄膜的方法。CN多晶硅膜微压传感器多晶硅膜微压传感器可用于低压和低真空系统中测量压力和真空度，采用高阻硅衬底和桥式结构多晶硅膜构成，其真空参考腔由两者在亚真空系统中沉积SiOsub/sub层实现真空封接，真空参考腔电容极板分别由衬底的重掺杂层和多晶硅重掺杂构成，其间距采用沉积SiOsub/sub层的度决定，控制精度高，具有结构简单工艺方便体积小和成本低等优点，不需要进行双面光刻对准和玻璃与硅的键合，便于大规模生产。CN在线淀积LPCVD多晶硅石英系统保护层装置一种在线淀积ＬＰＣＶＤ多晶硅石英系统保护层装置，属于半导体集成电路制造工艺中的低压化学汽相淀积技术。现有淀积技术在石英管管壁上未淀积保护层，当管壁上所淀多晶硅薄膜的厚度大于．μ时，在遇上较大的温度变化时（如断电）石英管较高温区部位就会产生极深的碎裂纹以致无法继续使用，本实用新型在原有的淀积装置上另放置一条氨气气路，在石英管内壁在淀积多晶硅薄膜前预先淀积一保护层，大大提高了工作效率，延长了石英管的使用寿命。CN多晶硅层的制作方法一种多晶硅层的制作方法，包括下列步骤：(a)提供一衬底；(b)于衬底上形成一阻障层；(c)于阻障层上形成一具有低热传导系数的多孔材料层；(d)于多孔材料层上形成一非晶硅层；以及(e)进行一激光退火制作工艺。

CN采用多晶硅栅和金属栅器件的半导体芯片使用单一工艺流程在单一基片上作成有金属栅和多晶硅栅的晶体管的一种半导体结构(及其制作方法)。CN在双金属/多晶硅氧化物氮化物氧化物硅阵列中的联结及选取步骤在本发明中，通过提供特别的阵列端结构及其制造方法，扩散位线的三抗阻层控制栅极及字栅极多晶硅(其是在控制栅极多晶硅可在扩散位线的顶部上运行处)，可非常有效地只与三层金属线联结，且保持最小金属间隔，联结方法亦可包含有一位扩散选择晶体管及/或一控制栅极线选择晶体管线，选择晶体管的目的可降低位线或控制栅极线的整体电容，或限制在编程及/或清除期间单元的接地次阵列收到的干扰情况。

CN制造具有低温多晶硅的顶栅型薄膜晶体管的方法本发明提供一种制造多晶硅薄膜晶体管的方法，该方法包括在基板上沉积非晶硅层，使非晶硅层结晶成多晶硅层，将多晶硅层制成一定图形使之形成薄膜晶体管的多晶硅有源层，在真空条件下，在多晶硅有源层上沉积氧化硅以形成栅极绝缘层，在真空条件下对栅极绝缘层进行加热使其退火并在退火的栅极绝缘层上形成栅极。CN用于动态阈值电压控制的多晶硅背栅SOIMOSFET提供了一种制作SOI金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)的方法。在SOIMOSFET器件中背栅起动态阈值电压控制系统的作用，因为多晶硅如何磨细,多晶硅棒热破碎装置多晶硅如何磨细,多晶硅棒热破碎装置适用于电路/系统运行期间和闲置期间。

CN形成多晶硅层以及制作多晶硅薄膜晶体管的方法一种形成多晶硅层的方法，包括：在衬底上形成一个非晶硅层；在非晶硅层上沉积一种催化剂金属；沿第一方向设置接触非晶硅层的第一和第二电极；在第一温度下加热非晶硅层，并同时对第一和第二电极施加第一电压而形成初次结晶非晶硅层；沿第二方向设置接触初次结晶非晶硅层的第三和第四电极，第二方向与第一方向不同；并且在第二温度下加热初次结晶非晶硅层并同时对第三

和第四电极施加第二电压而形成二次结晶非晶硅层。CN用于薄膜晶体管的多晶硅薄膜和使用该多晶硅薄膜的器件本发明涉及一种用于薄膜晶体管(TFT)的多晶硅薄膜和采用多晶硅如何磨细,多晶硅棒热破碎装置制造的器件，其中，通过提供一种TFT的多晶硅薄膜和TFT采用该多晶硅薄膜的器件，来改善TFT和器件的均匀性，该多晶硅薄膜的特征在于，对于互相垂直设置的晶体管TR和TR而言，最大数量的各个主要晶粒边界能够包含在有源沟道区中的概率P和P分别以下列表达式表示，概率P和P不等于。CN多晶硅的蚀刻方法本发明提供了一种多晶硅蚀刻方法，该方法在形成多晶硅层之后，能够完全除去用多晶硅层覆盖的凸起侧壁上遗留的多晶硅残余物，同时又保留了多晶硅层的形成各向异性，并且使下面的绝缘膜免受蚀刻。

CN多晶硅薄膜结晶品质的检测装置及其检测与控制方法本发明公开一种多晶硅薄膜结晶品质的检测装置及其检测与控制方法。之后，侦测第一光束及从这些第一多晶硅层反射的第二光束的光强度以获得多个光强度比率，并依据这些光强度比率来决定一第二既定能量密度。最后，以具有第二既定能量密度的激光对表面覆盖有一第二非晶硅层的第二衬底实施退火处理，以形成一第二多晶硅层。CN多晶硅层的制作方法一种多晶硅层的制作方法，包括下列步骤：(a)提供一基材；(b)于基材上形成一具有多个沟渠的缓冲层；(c)于缓冲层上形成一非晶硅层；以及(d)进行一激光退火工艺，使得非晶硅层熔融后由这些沟渠上方开始结晶，以形成一多晶硅层。

本发明可应用于低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器的制作，其所形成的多晶硅层具有较大的晶体尺寸以及较佳的均匀性。CN利用准分子激光退火工艺制作多晶硅薄膜的方法本发明提供一种利用准分子激光退火工艺制作多晶硅薄膜的方法，该方法首先于一衬底上形成一非晶硅薄膜，其中该非晶硅薄膜于靠近中央的第一区域上具有一第一厚度，而于靠近外缘的第二区域内具有一倾斜侧壁构造，其厚度向外递减。接着对该非晶硅薄膜进行厚度测量，以得到该非晶硅薄膜靠近外缘处的厚度分布，并据以设定该准分子激光退火工艺的工艺边界。

CNX多晶硅薄膜的晶粒尺寸的控制及其检测方法本发明公开一种多晶硅薄膜的晶粒尺寸的控制及其检测方法。

之后，藉由全光谱椭圆仪测量每一第一多晶硅区在一既定光子能量范围的光谱变化，并经由量化后得到一判断指标，以决定可形成最大多晶硅晶粒尺寸的激光能量密度。最后，以上述激光能量密度对第二非晶硅层实施退火处理，以获得最大多晶硅晶粒尺寸，并再藉由椭圆仪检测其晶粒尺寸。

CN多晶硅自行对准接触插塞与多晶硅共享源极线及制作方法本发明涉及一种多晶硅自行对准接触插塞与多晶硅共享源极线，形成于一半导体组件中，该半导体组件包括有沿Y轴方向相邻的一第一单元与一第二单元，每一个单元中包括有：一第一栅极结构以及一第二栅极结构，定义形成于一半导体硅基底的表面上；一侧壁子，分别形成于该第一栅极结构以及该第二栅极结构的侧壁上；一源极区域，形成于该第一栅极结构以及该第二栅极

结构之间的半导体硅基底内；以及一开口。CN一种四氯化硅多晶硅和石英玻璃的联合制备法本发明公开了一种四氯化硅多晶硅和石英玻璃的联合制备法，多晶硅如何磨细,多晶硅棒热破碎装置是以电解氯化氢水溶液获得的氯合成四氯化硅，获得的氢制备多晶硅；以多晶硅如何磨细,多晶硅棒热破碎装置还原炉的尾气制备石英玻璃；淋洗石英玻璃打砣机的尾气，淋洗后排出的尾液送入电解槽电解为氢和氯；氢和氯再次用于制备四氯化硅和多晶硅。

于其上，引起该重度掺杂的复晶半导体层第一导电类型的至少部分掺杂原子系进入该基极区域，以产生该第一导电类型的一射极区域。CNX用于宽编程的双金属/多晶硅氧化物氮化物氧化物硅存储器单元本发明提供一种存储器单元选择的方法，及获得宽编程带宽及EEPROM清除性能的操作，在取读期间，可同时选择在一存储器单元中的两储存区，再者，在编程期间，产生电流流动的能量来源可动态的从已选取位线上的储存电荷而获得，若位线电容无法足够提供一所需的电荷，从未选取位线借用额外的位线电容，或可使用一源极输出晶体管。CN玻璃衬底的预多晶硅被覆一种用于在预退火玻璃衬底上形成多晶硅层的方法和装置。在一个技术方案中，该方法包含：在沉积室中装载预退火玻璃衬底，在预退火玻璃衬底上沉积非晶硅层，对预退火玻璃衬底进行退火，以便在其上形成多晶硅层。CN低温多晶硅薄膜的制造方法及低温多晶硅薄膜晶体管一种低温多晶硅薄膜的制造方法，其方法首先在基板上形成一层非晶硅层，接着，对非晶硅层进行回火制程，使得非晶硅层转变成多晶硅层(多晶硅薄膜)，其中在回火的过程中，在多晶硅层的表面会形成数个突起物。利用本发明的方法所形成的多晶硅层其表面的突起物的尺寸明显变小，所以可以解决现有技术中突起物过大且大小不一致的问题。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/nrdSDuoJingkyqZm.html